



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт нанотехнологий микроэлектроники  
Российской академии наук  
(ИНМЭ РАН)

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А,  
тел. (495) 938-19-04, факс (495) 938-19-04  
ИНН 7724595010 КПП 773601001 ОГРН 1067758649375

23.10.2020 № 378/к

На № 20/2844 от 22.10.2020

Председателю диссертационного совета  
Д 212.268.04 на базе Томского  
государственного университета систем  
управления и радиоэлектроники,  
д.ф.-м.н., профессору Шандарову С.М.

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования  
«Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники».

Уважаемый Станислав Михайлович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук подтверждает согласие выступить ведущей организацией по диссертационной работе Филиппова Ивана Андреевича «Особенности применения плазменных технологий для формирования наноразмерных элементов плазмоники и гетероструктурных СВЧ транзисторов» по специальности 01.04.04 - «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Необходимые сведения прилагаются.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 стр. в 1 экз.

Заместитель директора  
по научной работе



А.А. Павлов

**Сведения о ведущей организации**  
по диссертационной работе **Филиппова Ивана Андреевича**  
на тему **«Особенности применения плазменных технологий для формирования наноразмерных элементов плазмоники и гетероструктурных СВЧ транзисторов»** на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности  
01.04.04 - «Физическая электроника»

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИНМЭ РАН
Почтовый индекс, адрес организации	119991 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А.
Веб-сайт	<a href="https://inme-ras.ru">https://inme-ras.ru</a>
Телефон	+7 (495) 938-19-04
Адрес электронной почты	<a href="mailto:org@inme-ras.ru">org@inme-ras.ru</a>
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коива Д.А., Дюдьбин Г.Д., Белов В.С., Рудаков Г.А., Булярский С.В. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ МАГНЕТРОНА И ПОТОКА КИСЛОРОДА НА МОРФОЛОГИЮ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА.// Нано- и микросистемная техника. 2019. Т. 21. № 8. С. 488-493.</li> <li>2. Saurov M.A., Bulyarskiy S.V., Lakalin A.V. INVESTIGATING THE FORMATION OF DEFECTS IN SILICON DURING GAMMA IRRADIATION.// Russian Microelectronics. 2020. Т. 49. № 2. С. 103-107.</li> <li>3. Булярский С.В., Светухин В.В., Кицюк Е.П., Шаманаев А.А., Рязанов Р.М. ЭМИССИЯ ШОТТКИ В КОНТАКТАХ ЗОЛОТО-УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ –ТИТАН.// Нано- и микросистемная техника. 2020. Т. 22. № 2. С. 59-63.</li> <li>4. Tikhomirova K.A., Tantardini C., Evlashin S.A., Oganov A.R., Kvashnin A.G., Sukhanova E.V., Popov Z.I., Kvashnin D.G., Tarkhov M.A., Dudin A.A., Zhdanov V.L. EXOTIC TWO-DIMENSIONAL STRUCTURE: THE FIRST CASE OF HEXAGONAL NaCl.// Journal of Physical Chemistry Letters. 2020. Т. 11. № 10. С. 3821-3827.</li> <li>5. Abdullaev D.A., Zubov D.N., Seregin D.S., Vorotilov K.A. EFFECTS OF VACUUM-PLASMA ETCHING ON THE ELECTRICAL PROPERTIES OF THIN FERROELECTRIC PZT FILMS.// В сборнике: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2019. С. 110221B.</li> <li>6. Bulyarskiy S.V. THE EFFECT OF ELECTRON-PHONON INTERACTION ON THE FORMATION OF REVERSE CURRENTS OF P-N-JUNCTIONS OF SILICON-BASED POWER SEMICONDUCTOR DEVICES.// Solid-State Electronics. 2019. Т. 160. С. 107624.</li> </ol>



7. Сивченко А.С., Кузнецов Е.В., Сауров А.Н.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ДО  
ОТКАЗА ПОДЗАТВОРНОГО ДИЭЛЕКТРИКА СУБ-  
100-НМ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ С ПОМОЩЬЮ  
УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. // Известия высших  
учебных заведений. Электроника. 2019. Т. 24. № 5. С.  
469-478.
8. Булярский С.В., Коива Д.А., Першина Е.А.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНОК  
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ОКСИДА ТИТАНА  
МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ.//  
Нано- и микросистемная техника. 2019. Т. 21. № 12.  
С. 720-726.
9. Ануфриев Ю.В., Зенова Е.В., Молоденский М.С.,  
Коива Д.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМОННЫХ  
ЭФФЕКТОВ В УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКАХ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ// Нано- и  
микросистемная техника. 2019. Т. 21. № 8. С. 457-464.
10. Соколов С.А., Милованов Р.А., Сидоров Л.Н.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИН ТОНКИХ ПЛЕНОК  
МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ  
МИКРОСКОПИИ И ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОГО  
РЕНТГЕНОВСКОГО АНАЛИЗА (ОБЗОР).//  
Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и  
нейтронные исследования. 2019. № 9. С. 54-66.
11. Komandin G.A., Nozdrin V.S., Gavdush A.A., Pronin  
A.A., Porodinkov O.E., Spektor I.E., Sigaev V.N.,  
Mikhailov A.A., Shakhgildyan G.Y., Ulitko V.E.,  
Abdullaev D.A. EFFECT OF MOISTURE  
ADSORPTION ON THE BROADBAND DIELECTRIC  
RESPONSE OF SiO<sub>2</sub>-BASED NANOPOROUS  
GLASS.// Journal of Applied Physics. 2019. Т. 126. №  
22. С. 224303.
12. Булярский С.В., Дудин А.А., Лакалин А.В., Орлов  
А.П., Павлов А.А., Рязанов Р.М., Шаманаев А.А.  
СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ  
ОДИНОЧНОЙ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ.//  
Журнал технической физики. 2018. Т. 88. № 6. С. 920-  
925.

Верно

Заместитель директора  
по научной работе



А.А.Павлов

« 23 » 10 2020 г.